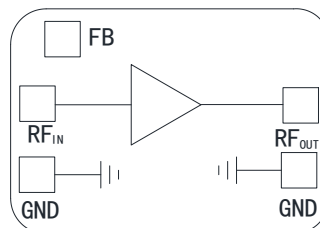


特点：

- 频率范围：0.02~2.0GHz
- 增益：20dB@5V; 20.5dB@8V
- 噪声系数：0.9dB@5V; 1dB@8V
- 输出 1dB 压缩点：22dBm@5V; 26.5dBm@8V
- 单电源工作：+5V@60mA; +8V@95mA
- 芯片尺寸：0.8mm×0.76mm×0.1mm

功能框图：



产品简介：

YDC1128 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理，适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

性能参数：（50Ω系统， $T_A=+25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{dd}=+5\text{V}$ ， $I_{dd}=60\text{mA}$ ）

参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	Frequency	0.02	-	2.0	GHz
增益	Gain	-	20	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	± 0.7	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.5:1	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.4:1	-	-
噪声系数	NF	-	0.9	-	dB
反向隔离度	IR	-	23.5	-	dB
输出 P-1dB	OP _{-1dB}	-	22	-	dBm
输出 IP ₃ *	OIP ₃	-	35	-	dBm
电源电压	V_{dd}	-	+5	-	V
工作电流	I_{dd}	-	60	-	mA

*: OIP₃ 测试条件：双音信号间隔 1MHz，P_{out}=0dBm/tone。

**: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

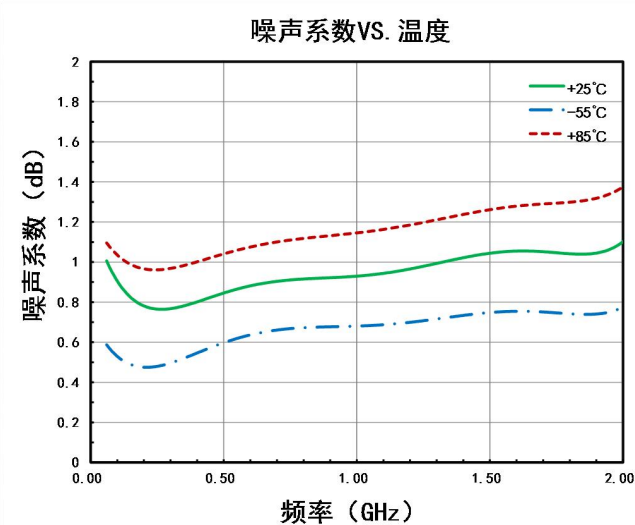
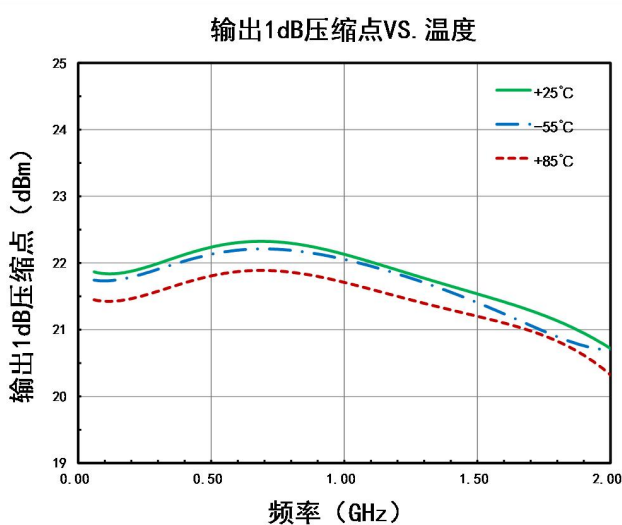
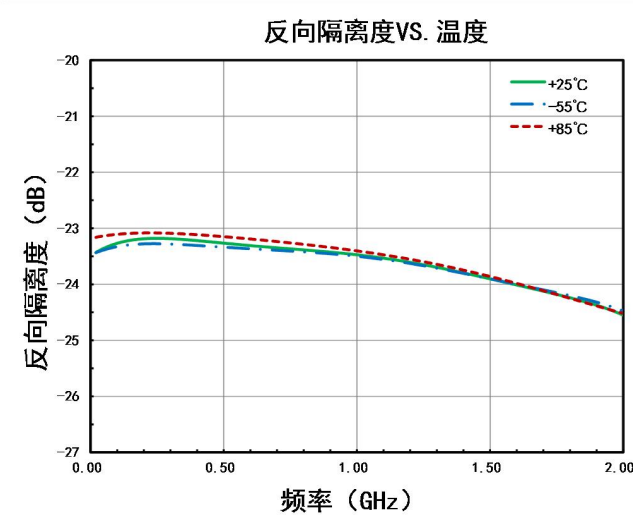
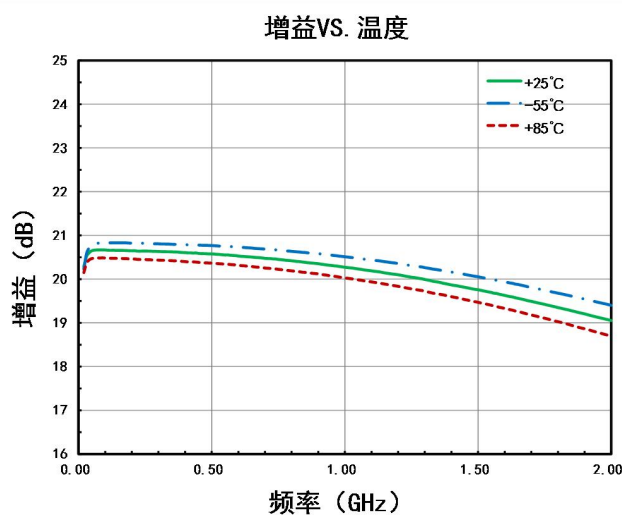
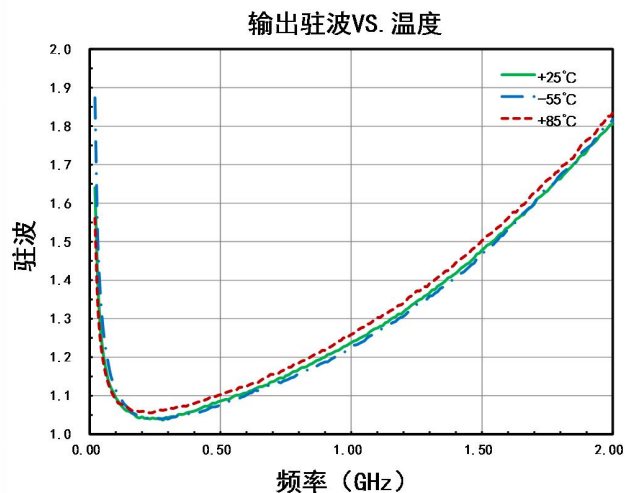
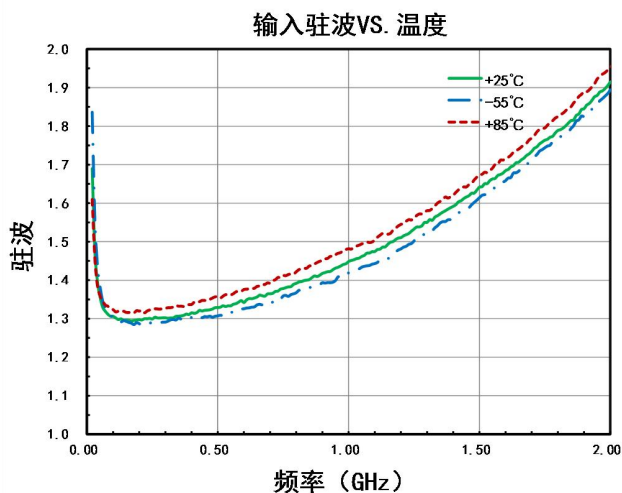
性能参数：（50Ω系统， $T_A=+25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{dd}=+8\text{V}$ ， $I_{dd}=95\text{mA}$ ）

参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	Frequency	0.02	-	2.0	GHz
增益	Gain	-	20.5	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	± 0.7	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.5:1	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.4:1	-	-
噪声系数	NF	-	1	-	dB
反向隔离度	IR	-	24	-	dB
输出 P-1dB	OP _{-1dB}	-	26.5	-	dBm
输出 IP ₃ *	OIP ₃	-	37	-	dBm
电源电压	V_{dd}	-	+8	-	V
工作电流	I_{dd}	-	95	-	mA

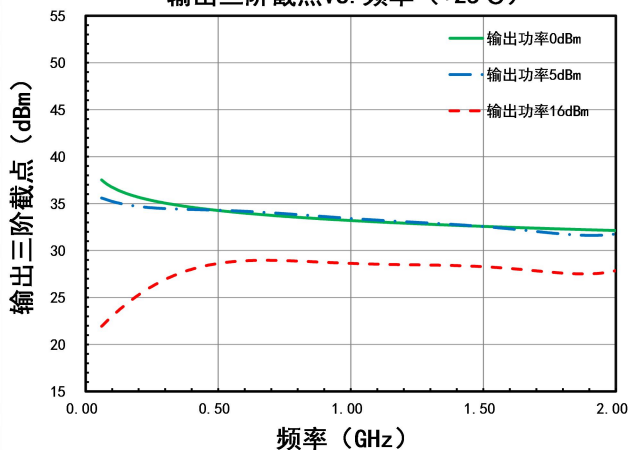
*: OIP₃ 测试条件：双音信号间隔 1MHz，P_{out}=+5dBm/tone。

**: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

典型测试曲线：(50Ω系统, $V_{dd}=+5V$, $I_{dd}=60mA$)

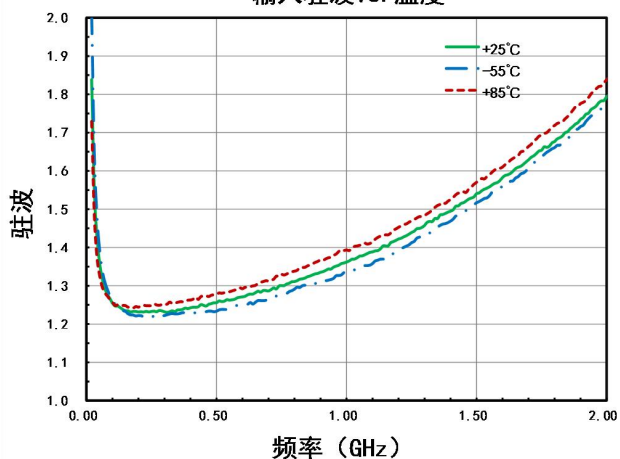


输出三阶截点VS. 频率 (+25°C)

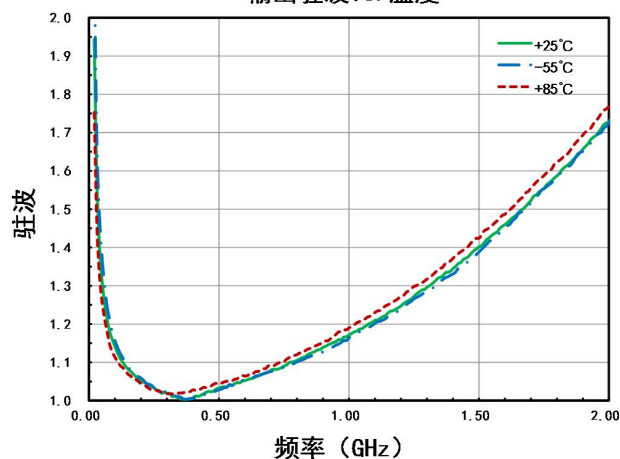


典型测试曲线: (50Ω系统, $V_{dd}=+8V$, $I_{dd}=95mA$)

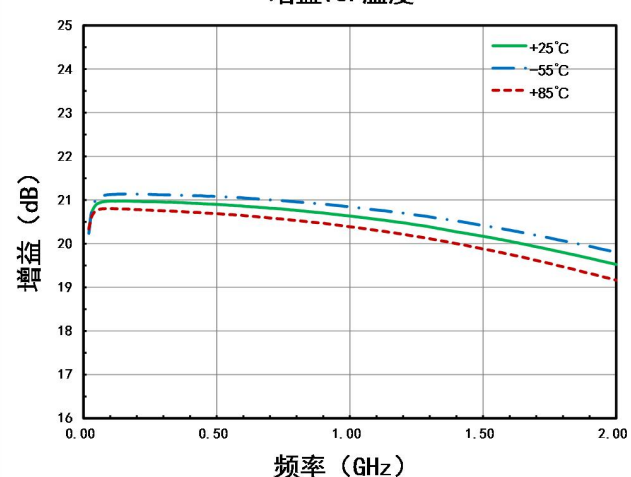
输入驻波VS. 温度



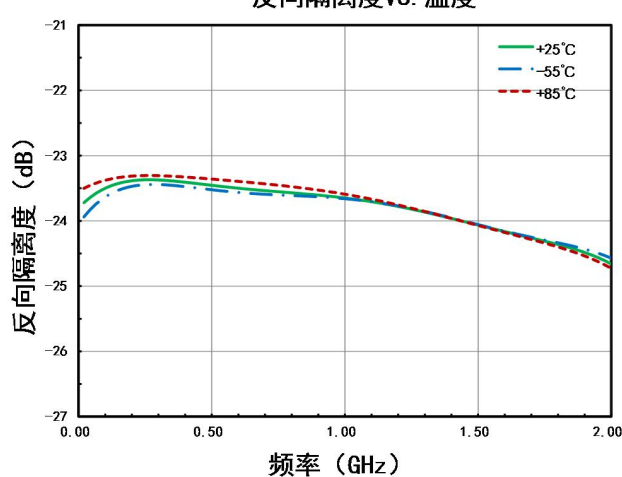
输出驻波VS. 温度



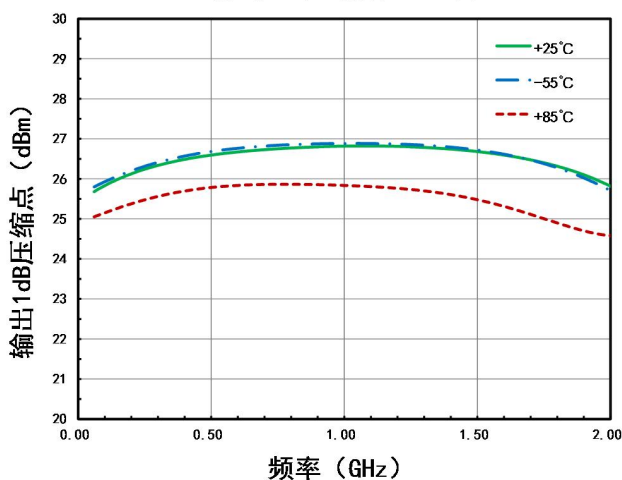
增益VS. 温度



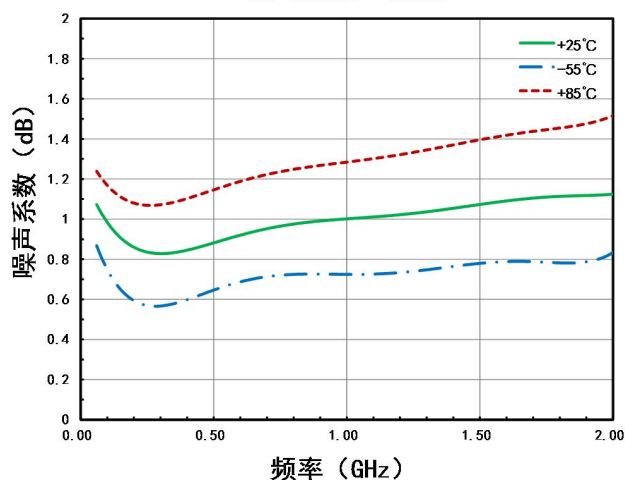
反向隔离度VS. 温度



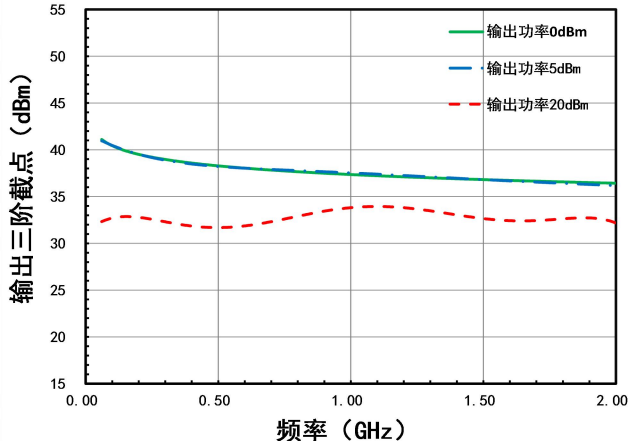
输出1dB压缩点VS. 温度



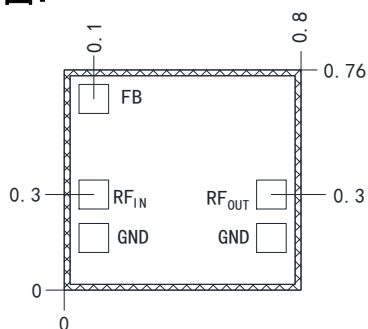
噪声系数VS. 温度



输出三阶截点VS. 频率 (+25°C)



外形尺寸图:



注: 1.单位: mm;

2.芯片背面镀金, 背面接地;

3.外形尺寸公差: $\pm 0.05\text{mm}$;

4.键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1 \times 0.1\text{mm}$ 。



引脚定义:

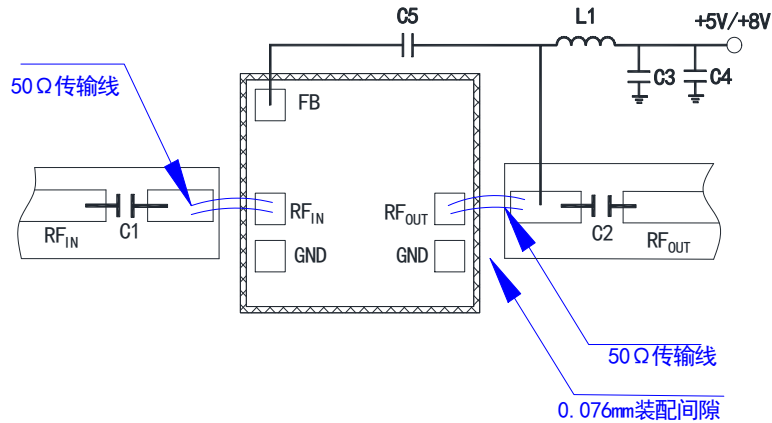
符号	描述
RF _{IN}	射频输入, 内部无隔直
RF _{OUT}	射频输出, 内部无隔直
FB	外接反馈电容
GND/芯片背面	接地, 芯片底部需接地良好

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率, 50 Ω	+20dBm
电源电压	+10V
装配温度	+300°C, 20s
工作温度	-55°C~+85°C
贮存温度	-55°C~+150°C
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

推荐装配图：



注：射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸，典型的装配间隙是 0.076~0.152mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm 。

推荐应用电路器件值：

频率 编号	0.02~0.6GHz	1.0~2.0GHz	0.1~2.0GHz	备注
	推荐值			
C1	10nF	100pF	3300pF	
C2	10nF	100pF	3300pF	
C3	10nF	10nF	10nF	
C4	1uF	1uF	1uF	
C5	4700pF	4700pF	4700pF	
L1	1.5uH	150nH	100MHz@1800Ω磁珠	电流>150mA

注：电容、电感、磁珠可根据实际使用频段选用。

产品使用注意事项：

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面，使用时须小心。
3. 芯片粘结装配时，需考虑热膨胀应力对芯片的影响，芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上，如可伐、钨铜或钼铜垫片上，避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过+300 $^{\circ}\text{C}$ ，时间不能超过 20 秒），使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 25 μm 双金丝键合，建议金丝长度 0.25~0.40mm（10~16 mils）。
6. 在存储和使用过程中注意防静电，烧结、键合台接地良好。